



เอกสารอ้างอิง

1. Hovel, H.J. Semiconductors and Semimentals. Vol. 11. New York: Academic Press, 1975.
2. Jurgen, R.M.A. Introduction to Classical and Modern Optics. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1972.
3. Hannay, N.B. Semiconductors. New York: Reinhold Publishing Corporation, 1959.
4. Spitzer, W., and Fan, H.Y. "Infrared Absorption in n-Type Silicon." Physical Review 108 (October 1957): 268-271.
5. Stickler, R., and Booker, G.R. "Nature of the Damaged Layer on Abraded Silicon Specimens." Journal of the Electrochemical Society 109 (August 1962): 743-744.
6. Stickler, R., and Booker, G.R. "Surface Damage on Abraded Silicon Specimens." Phil. Mag. 8 (May 1963): 859-876.
7. Pugh, E.N., and Samuels, L.E. "Damaged Layers in Abraded Silicon Surfaces." Journal of the Electrochemical Society 111 (December 1964): 1429-1431.
8. Pugh, E.N., and Samuels, L.E. "Etching of Abraded Germanium Surfaces with CP-4 Reagent." Journal of the Electrochemical Society 109 (May 1962): 409-412.
9. Thomas, D.J.D. "Surface Damage and Copper Precipitation in Silicon." Phys. Stat. Sol. 3 (1963): 2261-2273.

10. Green, D., et al. "Observation of Parallel Arrays of Pure Edge Dislocations in Silicon." Journal of Applied Physics 39(May 1968): 2937-2939.
11. Dash, W.C. "Distorted Layers in Silicon Produced by Grinding and Polishing." Letters to the Editors, Physical Review [n.d.]: 228-229.
12. Bennett, H.E., and Porteus, J.O. "Relation Between Surface Roughness and Specular Reflectance at Normal Incidence." Journal of the Optical Society of America 51 (February 1961): 123-129.
13. Clarke, E.N. and Hopkins, R.L. "Electrical Conductivity of Mechanically Disturbed Germanium Surfaces." Physical Review 91 (September 1953): 1566-1567.
14. Baker, D., and Yemm, H. "The Depth of Surface Damage Produced by Lapping Germanium Monocrystals." British Journal of Applied Physics 8 (July 1957): 302-303.
15. Widmer, H. "Effect of Dislocation on Self-Diffusion in Germanium." Physical Review 125 (January 1962): 30-32.
16. Buck, T.M. and Mckim, F.S. "Depth of Surface Damage Due to Abrasion on Germanium." Journal of the Electrochemical Society 103 (November 1956): 593-597.
17. Wert, C.A., and Robb, M.T. Physics of Solids. 2d ed. Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha, 1964.
18. Hull, D., Introduction to Dislocations. Glasgow: Pergamon Press, 1965.

19. Kittel, C., Introduction to Solid State Physics. 5th ed. New York: John Wiley and Sons, 1976.
20. MacCrone, R.K., Treatise on Materials Science and Technology. Vol.11. New York : Academic Press, 1977.
21. Read, W.T., "Theory of Dislocations in Germanium." Phil. Mag. 45 (August 1954): 775-796.
22. Glaemzer, R.H. and Jordan, A.G., Solid state Electron. 12 (1969): 259-266.
23. Lawrence, J.E., Journal of the Electrochemical Society 115 (1968): 860-865.
24. Donovarr, T.M., et al. "Effect of Surface Damage on the Reflectance of Germanium in the 2650-10000 Å Region." Journal of the Optical Society of America 53 (December 1963): 1403-1409.
25. Cardona, M., et al. "Effect of Temperature and Doping on the Reflectivity of Germanium in the Fundamental Absorption Region." Physical Review 122 (June 1961): 1382-1388.
26. อัจฉริยะ โสโน. "การวัดความหนาของชั้นออกไซด์บนแผ่นผลึกซิลิกอน." , วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต, แผนกวิศวกรรมไฟฟ้า, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร, 2522

ประวัติผู้เขียน

นาย ชุมพล อंतरเสน เกิดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2495 ณ. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2519 หลังจากนั้นได้ทำงานอยู่ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นเวลา 2 ปี จนถึง พ.ศ. 2521 จึงกลับมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทบัณฑิต ณ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

